

阿部 哲郎

<tetsuo.abe@kek.jp>

高エネルギー加速器研究機構(KEK)/加速器研究施設

第41回高エネルギー加速器セミナーOHO(OHO'24)

2024年9月10日

内容

- 1. 新しい常伝導電子加速管の製作方式
 - ●『縦方向分割方式』
 - 目的: 高いコストパフォーマンス

- 2. 金属製空洞を使った、より高い加速周波数の研究開発状況 ●加速器の進化すべき方向?
 - 加速器の進化すべき方向?



常伝導電子加速管の例

V/ µm 230 📥 200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 -1e-field (f=11.4253) (1)1.41426708.2 11.4253 GHz Frequency Phase 0° Cross section Α Cutplane at Y 0.000 mm Maximum on Plane (Plot) 209.154 V/µm Maximum (Plot) 393.484 V/um

共振周波数: 11.4 GHz

電界ベクトル

単セル空洞がビーム進行方向に連なり、 効率的に加速できる









OHO'24 (2024-09-10)

阿部 哲郎(KEK加速器)

7

Postmortem of TD18_Disk





Max. current density 2×10^{8} A/cm² during test



Surface magnetic field \rightarrow

2つの「直交」する加速管製作方式

詳しくは下記参照: <u>阿部 哲郎</u>他、「高電界Xバンド単セル試験空洞の <u>4分割方式による製作」</u> (第9回日本加速器学会年会、THPS095、2012年)





減衰型ディスク スタックした状態(拡散接合後)

■ 利点

- ✓ 旋盤で主要部分を加工可能
- ✓ 平滑な表面が比較的簡単に得られる(R_a < 100 nm)</p>

■ 欠点

- ✓ ディスクを一枚一枚超精密加工し、慎重に重ねる(数 十枚以上)
- ✓ 手間がかかる
- ✓ 加速モードによる表面電流が(多くの)ディスク間接合 箇所を渡る





1個のQuadrant

3個のQuadrants

- ✓ 主要部分のパーツの個数は、セル数に依らず、2個(2分割) または4個(4分割)
- ✓ (5軸の)ミリング加工機で一気に加工可能

✓ 組立は比較的容易

- → 大幅なコストダウンの可能性あり
- ✓ 加速モードによる表面電流は、いかなる接合箇所も渡らない
- ✓ 加速フィールドから見えない箇所で接合できる

■ 欠点

■ 利点

- ✓ すべてミリング加工なので、表面粗さ大(R_a > 100 nm)
- ✓ 分割部間からの仮想リークの恐れ → 改良版で解決済
- ✓ 分割部の角におけるフィールド増大 → 改良版で解決済

18セルの<u>CLIC</u>プロトタイプ加速管(進行波)を4分割型で製作 (2008年、by KEK and SLAC) TD18_Quad

(加速モード周波数: 11.4 GHz) 超精密ミリング加工(輪郭度:5μm)



超精密アライメント(精度:5 μm)







R面取り(R50µm)

阿部哲郎(KEK加速器)

Installed into <u>Nextef</u>1

(KEK <u>Ne</u>w <u>X</u>-band <u>Te</u>st <u>F</u>acility) (11.4 GHz)



3dB phase check

Nextef setup







TD18_Quadの高電界試験の結果(2009年)



DESIGN IMPROVEMENT 角部Rとギャップサイズは、フィールド増大とシャントインピーダンスの劣化を最小にするよう同時最適化した: A) フィールド増大: 25% B) シャントインピーダンス:-2% ✓ 仮想リークの可能性をなくす
 ✓ フィールド増大を抑制する 詳しくは下記参照: 阿部 哲郎 他、「4分割方式による高電界試験用Xバンド単セル空洞の製作」 (第11回日本加速器学会年会、SUP042、2014年) 旧デザイン 改良版 ← アイリス周辺の写真 → (→ 高電界性能出ず) 4分割部A' 4分割部A 微小ギャップ 4分割部B (0.1 mm)平面で 大きなR コンタクト (8xR0.4mm) → 仮想リーク源? 4分割部B' $8 \times R50 \mu m$ → 大きなフィールド増大

Field enhancements due to misalignment of quadrants



Numerically Calculated by the Floating Random Walk Method with Accuracies Better than 0.5%

阿部哲郎、「微細構造による導体表面電磁場の変化に関する研究」、第8回日本加速器学会年会、TUPS086 (2011)



阿部 哲郎(KEK加速器

Field Enhancement Factor

[UM]

Shunt Impedance



OHO'24 (2024-09-10)

超精密組立

<u> 組立精度:10 μm 達成!</u>

For details, see <u>T. Abe *et al.*, "Basic Study on High-Gradient</u> <u>Accelerating Structures at KEK/Nextef," in Proceedings</u> <u>of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator</u> <u>Society of Japan, August 2015 (Paper ID: WEP060).</u>

作業者:高富 俊和 氏(KEK 機械工学センター)





OHO'24 (2024-09-10)





ビードプル法で測定した 軸上の加速フィールド分布↓









テストスタンド(Nextef1 / Shield-B) ヘインストール









Jan. 23, 2017



大電力RFコンディショニング履歴



<mark>E_{acc} = 125 MV/m まで</mark> 問題なくコンディショニング出来た!



(もっと上まで行けたが、 試験期間の都合で、 ここまでとなった)

ブレークダウン(真空放電)の検出法





✓ 2つの独立した方法で、ブレークダウン検出数の違いは1割程度
 ✓ ブレークダウイン率の正確な測定を実現



(大電力RFコンディショニング後の)ブレークダウン率測定結果@KEK/Nextef1(2017年)





改良4分割方式の完全な原理実証のため、 24セルのCLICプロトタイプ加速管(進行波)を製作





阿部哲郎(KEK加速器)

250.00

Full Å

5.00

0.00

ReEz/10000

200.00

2.50

Full 🔺

製作図面(3D)



超精密ミリング加エ

加工者:<u>ユー・コーポレーション</u>

5 µm の精度で組立

電子ビーム溶接(EBW)による接合

<mark>ディスク積層方式でも可能だが、困難</mark>

本溶接の条件

・加速電圧: 150 kV ・ビーム電流: 10 mA ・送りスピード: 750 mm/min ・フォーカス ポイント: 20 mm 上

→ 溶け込み深さ:約1.5 mm
 → 物温上昇:最高25℃

↓EBW完了後

溶接者: <u>太陽イービーテック</u>

EBWによる直角方向サイズの変化を測定

測定器:カール ツァイスUPMC 850 CARAT

✓ 平均で 5 µm の縮み ✓ ばらつきは 2~3 µm

低電力RF測定のセットアップ

【参考】導波管型HOM減衰構造のあるCLICプロトタイプ加速管(Xバンド進行波)の加速電界強度分布の測定結果(<u>周波数調整前</u>)

OHO'24 (2024-09-10)

同様の現象は、Cバンド小型加速管開発でもあった

サイドカップル型定在波管の加速モード電界

(Valery Dolgashev (SLAC), presented at HG2023 より抜粋)

Cバンド小型加速管の加速電界強度分布の測定結果

詳しくは、下記参照:

木村 優志 他、「縦方向分割方式Cバンド小型加速管の製作」、第21回日本加速器学会年会、FRP042(2023年8月)

周波数調整前でも、測定値は設計値とよく合っている!

周波数調整前では、測定値と設計値に乖離あり!

フルスケール加速管(CLIC用プロトタイプ)を改良縦方向分割方式で製作 (11.4GHz、進行波) (第16回日本加速器学会年金、WEOH04,2019年)

TD24R10_QUAD-R04G01_K1

✓ 製作は完了

✓ Nextef1の火災により、高電界試験は未実施のまま

縦方向分割の例1: CLIC用加速管

Waveguide Input Couplers CLIC-G-Open

- 周波数:11.994 GHz
 - 2分割間のギャップは1mmと大きい
- CERN/CLICのXバンド高電界試験スタンド (Xbox-2)で試験
 - 従来のディスク積層方式加速管並みの性能 が出た(若干、ディスク積層方式より悪い?)
- ギャップが大きいのがよくないか?

(曲率が一定割合で変化する曲線)

Extracted from: <u>R. Peacock: "Experimental Investigation of</u> <u>Vacuum Breakdown Triggering Mechanisms</u> in a DC Electrode System", PhD thesis, Lancaster <u>University (2023)</u>.

Figure 2.18: Physical shape of edges for Euler spiral, Euler spiral approximation, ellipse and a 1 mm radius.

- 分割角部におけるフィールド増大 は、0.1%のレベルまで抑えること ができる
- 但し、一般的に、複雑に入り組ん だ曲面は、不具合発生のリスク あり
 - ソリッドモデル作成時
 - NC加工にデータを渡す時

Figure 2.19: Normalised electric field on the anode for electrodes the same size and with an offset of 0.5 mm to replicate a small anode to large cathode for the different edge shapes, Euler spiral approximation, ellipse and a 1 mm radius.

0.08

縦方向分割の例2: C³ (Cool Copper Collider)用加速管

1m長のDCS (Distributed-Coupling Structure)加速管を2分割型の縦方向分割方式で製作

 C^3 : A "Cool" Route to the Higgs Boson and Beyond

(具体的な技術課題は、Demonstration facility にて実証予定)

OHO'24 (2024-09-10)

C³加速器開発状況: 2分割部のろう付け

LCWS2024ワークショップより抜粋: <u>https://agenda.linearcollider.org/event/10134/contributions/54546/</u>

【RF空洞の基礎知識1】空洞共振器のQ₀値(内部Q値や無負荷Q値とも言う)

(Internal Q-value) (Unloaded Q-value)

壁面損失パワー: Pwall

U

$$P_{wall} = R_S \frac{1}{2} \int_{cavity} dS \left| \vec{H} \right|^2$$

$$= \frac{\rho_{dc}}{\delta_{skin}} \frac{1}{2} \int_{cavity} dS \left| \vec{H} \right|^2$$

$$(R_s = \rho_{dc} / \delta_{skin} : \frac{2\pi \delta_{skin}}{(\Gamma_{cavity})} \delta_{skin} : \frac{2\pi \delta_{skin}}{(\Gamma_{cavity})} \delta_{skin}$$

. .

【RF空洞の基礎知識2】様々なQ値

Q値(quality factor)
$$U = \omega \frac{U}{P_{???}}$$
 $\omega: \overline{\varepsilon} = \overline{\omega} \frac{\omega}{U}$ $U: \overline{\varepsilon}$ $\omega: \overline{\varepsilon} = \overline{\omega} \frac{\omega}{U}$ $U: \overline{\varepsilon}$ $\omega: \overline{\varepsilon} = \overline{\omega} \frac{\omega}{U}$

 $\begin{cases} \textbf{内部Q値}: Q_0 = \omega \frac{U}{P_{wall}} \quad (P_{wall}: 2\pi p_{wall}: 2\pi p_{$

図 20 空洞内電磁場を励振するために空洞側面に 導波管を付けた状態の模式図。

空洞への給電をいきなり切った場合、

【RF空洞の基礎知識3】Fill(ing) time

例:高周波源(クライストロン)が緊急停止した時の SuperKEKB/DR用加速空洞のピックアップ信号(緑色) (実験データ)

- ✓ 赤色破線は包絡線
- ✓ 509 MHz, Q_L =13000 → T_f = 8 µs

Q値の測定に使われることがある(特に超伝導空洞)

加速空洞内に 加速フィールドを 励振する場合

✓ Q値が高いとビーム加速できるまでに時間がかかってしまう

✓ 周波数が高い程、fill timeは短い(T_{f-}∝ freq^{-3/2})

→ たとえQ値が高くても、周波数を 上げれば fill time を短くできる

OHO'24 (2024-09-10)

(本題に戻って、)なぜ常伝導加速器で高い周波数か?

$$\frac{\frac{R_{sh}}{L}}{L} = \frac{|V_c|^2}{P_{wall}} \frac{1}{L} = \frac{\left|\int_0^L dz \, E_z(\vec{x}) \, e^{-i\omega \frac{z}{c}}\right|^2 / L}{\frac{R_s}{2} \int_{cavity} dS \, \left|\vec{\mathbf{H}}(\vec{x})\right|^2}$$

- 2. 加速効率が上がる
 - 加速効率を表す「単位長さあたりのシャント・インピーダンス(R_{sh}/L)」の周波数(f)依存性:

RF Frequncy vs Shunt impedance (Rres=10nohm)

周波数を上げれば上げる程、加速効率が上がる!

(但し、異常表皮効果が効く500 GHz 以上では この限りではない)

加速周波数帯域

■ Sバンド(2~4 GHz、波長:7.5~15 cm)

- これまでの主流(KEK電子陽電子入射器など)
- 運転加速勾配の例: ~20 MV/m @ KEK電子陽電子入射器
- Cバンド(4~8 GHz、波長:3.7~7.5 cm)
 - 近年、世界中で花盛り(SACLA, ナノテラス, SwissFEL, SXFEL など)
 - 運転加速勾配の例: ~38 MV/m @ SACLA
- <mark>Xバンド</mark>(8~12 GHz、波長 : 2.5~3.7 cm)
 - 大型加速器(実機)の運転で使用された実績はない
 - CERNの常伝導リニアコライダー計画 <u>CLIC</u> で採用
 ▶運転加速勾配: 72~100 MV/m(CLICの仕様)

Sバンド(2.856 GHz) のディスク1枚

Cバンド(5.712 GHz) のディスク1枚

Xバンド(11.424 GHz)

のディスク1枚

加速器の大幅な小型化

(KEK 電子陽電子入射器の地下加速器トンネル内にて撮影)

どちらも、加速管1本で電子ビームを40 MeV (定格)加速

さらなる高い加速周波数への挑戦

米国SLAC国立加速器研究所が製作した110 GHz 加速試験構造

110 GHz 加速試験構造の高電界試験@米国MIT

- ✓ 加速勾配 230 MV/m (ILCの約7倍)まで達した
- ✓ ジャイロトロンを使った試験方法に困難があり停滞
- ✓ 高い周波数の加速構造の開発では、大電力マイクロ波源が重要

97.5% HE₁₁ mode

Dr. Jérémy Ge

High Gradient Measurements at 110 GHz

<u>高電界加速の国際ワークショップHG2021</u>におけるM. Othman 氏の発表スライドより抜粋

SLAC

Processing Timeline: Gradient of 230 MV/m at 10⁵ Pulses

高電界加速の国際ワークショップHG2021 におけるM. Othman 氏の発表スライドより抜粋

Rapid processing of the cavity is essential for high gradient applications

110 GHz 試験空洞の高電界試験の結果に関する(阿部の)考察

- BDR in the last 10³ pulses from 1.5×10^5 pulses at E_{acc} = 230 MV/m is ~1/pulse/m.
 - まだコンディショニングの余地はあるとのこと
 > CLIC用Xバンド加速管の大電力コンディショニングでは、数百万パルス以上
 - 最高1Hz運転なので、これ以上の統計は難しい
- CLIC用加速管のBDR仕様値は、3×10⁻⁷ /pulse/m at E_{acc}= 100 MV/m for (パルス幅) = 180 ns (矩形パルス相当)と比較
 - Xバンド高電界加速管のBDRのスケーリング則: BDR ∝ (*E_{acc}*)³⁰×(パルス幅)⁵
 - *E*_{acc}=230 MV/m では、CLICのBDR仕様値は ~20000 /pulse/m
 - 110GHzの上記BDRは、*E*_{acc}=230 MV/m の加速勾配にしては、かなり低い?

(BDR : BreakDown Rate)

CLIC用Xバンド高電界加速管の大電力RFコンディショニング例

300 GHz 加速試験構造

G Band Single Cell Accelerator Cavity

(前述の110GHz構造の相似形)

G Band Accelerator Structure and Mode Converter

-SLAC

Iris aperture radius 104 µm (~ λ /10) Gaussian **Beam Input** 10 mm 4.8×10⁷ S/m σ copper (300 GHz) **Electric Field** Skin depth (300 GHz) 0.13 µm MV/m 700 Phase, advance/cell 180 deg. $\frac{R_{sh}/L}{K} \propto \sqrt{f}$ 100 kW @ 300 GHz Q ~3000 (←近い将来、測定予定) 非常に高いシャントインピ--> Shunt impedance ~600 MΩ/m (←近い将来、測定予定) Tapered Accelerating Structure Steady state gradient ~350 MV/m at 100 kW dissipated power horn \rightarrow Fill time 1.6 ns 短い充垣時間 (Fill time) $\propto f^{-3/2}$ 空洞部分のモックアップ Axis of Cylindrical Symmetry Standing-Wave Cavities Fabricated G band **Diagnostic RF Port** (→RFパルス幅が短いので、低いパルス加熱温度 Structure (EDM) → 低いブレークダウン率が期待できる) TE11 to TM ブレークダウン率と強い相関のある 0.5 mm パルス加熱による内表面温度上昇は、 SLACが120~140GHz加速構造にビームを入射 Xバンドの場合の1/10 する高電界試験を行い、加速勾配 300 MV/m くらいまでは、銅表面の破壊は無いことがわ かった Phys. Rev. Accel. Beams 19, 011301 – Published 6 January, 2016

銅のSkin depthと自由電子の平均自由行程

300 GHz 金属製加速空洞

小型化のデメリット

- ・加速構造が小さくなり、製作が難しくなる
 - ・近年の超精密加工技術では、ミクロンオーダーの加工精度の達成は難しくなくなってきている
- 加速器のアライメントやビーム制御等における要求精度 が高くなる
- ・大電力波源の開発が必要
 - ・より高い周波数では、(加速器でよく使う)電子管ベースの大電 カマイクロ波源の出力は落ちる(∝1/f²)
 - ・数百GHz(サブテラヘルツ)まで行けば、レーザー駆動の大電力 光源が使える

→『サブテラヘルツ加速器』

<u>高電界加速の国際ワークショップHG2021</u>における <u>M. Othman 氏の発表スライド</u>より抜粋↓

Nature Photonics. 1 (2), (2007) Science 318 (2007) J Phys. D: Appl. Phys. 50.4 (2017)

高エネルギー高電界加速技術の展望(予想図)

高エネルギー高電界電子加速技術は進化を遂げるか?

常伝導金属空洞製サブテラヘルツ加速器の特徴

■ 超小型_(でも製作可能)、高い加速効率

- 500 GHzを超えると製作性や加速効率の観点から得をしない
- 既存の加速器との親和性あり
 - 従来のマイクロ波加速の延長上の技術
 - 既存の加速器で可能なことは(原理的には)可能なはず
 ▶ 例: 高いコンディショニング効果(コンディショニングでブレークダウン率を下げることができる)
- レーザー駆動のテラヘルツ光源が使える
 - 大電力レーザーの技術は日進月歩
- 6G通信では 300 GHz帯も使われる予定
- Xバンドからテラヘルツ加速器(数十テラヘルツ帯)への橋渡しとなる

